

	<p>SIR892DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR892DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SIR892DP-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 852166 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SIR892DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	852166 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.6V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR892DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2645pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 50A (Tc) 5W (Ta), 50W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SIR892DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR892DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR892DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIR892DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR928-6C-F Everlight Electronics Co Ltd EMITTER IR 875NM 100MA RADIAL</p>	 <p>SIR892DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR890DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA00DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 100A PPAK SO-8</p>
 <p>SIR890DP-T1-E3 VISHAY SIR890DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIRA00DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 100A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR892DP-T1-GE3-S VISHAY SIR892DP-T1-GE3-S VISHAY</p>	 <p>SIR890DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8</p>

SIR892DP-T1-GE3 Zugehöriges Mehr

Schlüsselwort	SIR892DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR892DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR892DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR892DP-T1-GE3
SIR892DP-T1-GE3 Electronic	SIR892DP-T1-GE3-Komponenten	SIR892DP-T1-GE3-Verteiler	SIR892DP-T1-GE3-Bild	SIR892DP-T1-GE3-Teil
SIR892DP-T1-GE3 Preis	SIR892DP-T1-GE3 Hersteller	SIR892DP-T1-GE3 Bild	SIR892DP-T1-GE3 Aktie	SIR892DP-T1-GE3 Inventar
SIR892DP-T1-GE3 Neu	SIR892DP-T1-GE3 Original	SIR892DP-T1-GE3 garantiert	SIR892DP-T1-GE3 RFQ	SIR892DP-T1-GE3 Online bestellen